SINGLE CRYSTAL GROWTH DEVICE

Patent Number:

JP3279290

Publication date:

1991-12-10

Inventor(s):

SAKURADA SHINICHI

Applicant(s):

OSAKA TITANIUM CO LTD; others: 01

Requested Patent:

Application Number: JP19900081688 19900329

Priority Number(s):

IPC Classification:

C30B15/14; H01L21/208

EC Classification:

Equivalents:

JP2852345B2

Abstract

PURPOSE: To facilitate the adjustment of a distance between the lower end of a radiation screen and the surface of the melted liquid and homogenize the oxygen concentration of a single crystal by suspending and holding the radiation screen in a chamber with vertically threadedly proceeding suspenders attached to the upper plate of the chamber.

CONSTITUTION: Plural guide lever 15 are inserted into suspenders 9 comprising a driving suspender 9a and a driven suspender 9b inserted into a slide plate 16 fit and fixed in an overhanging state to the periphery of holes 14 penetrated in the upper plate 1b of a chamber, and plural hook-like pieces 11 are projectedly disposed on the bottom surface of a holder 10 fixed to the lower end of the suspender 9. The edge portions 8a of the radiation screen 8 are attached to the hook-like pieces 11 in a detachable state. A male screw shaft 12 projectedly disposed on the upper end of the suspender 9a is engaged with a female screw cylinder 13 disposed on the upper plate 1b, and the screw cylinder 13 is rotated to integrally vertically move the holder 10, the suspender 9b and the screen 8 through the suspender 9a.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-279290

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)12月10日

C 30 B 15/14 H 01 L 21/208 8924-4G P 7630-4M

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

会発明の名称

単結晶成長装置

②特 願 平2-81688

郊出 願 平2(1990)3月29日

@発 明 者

晋 一 兵庫県尼崎市東浜町1番地 大阪チタニウム製造株式会社

勿出 頤 人

大阪チタニウム製造株

兵庫県尼崎市東浜町1番地

式会社

桜 田

の出 願 人

九州電子金属株式会社

佐賀県杵島郡江北町大字上小田2201番地

四代 理 人

弁理士 森 正澄

明 細 書

1. 発明の名称

単結晶成長装置

2. 特許請求の範囲

チャンパ内の単結晶引上げ領域の周囲に輻射ス クリーンを配設してなる単結晶成長装置であっ て、

チャンパの上板に、上下方向へ螺進退可能に懸 吊材を取付け、該懸吊材によって、輻射スクリー ンをチャンパ内に吊下保持させたことを特徴とす る単結晶成長装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は、単結晶の引上げ領域の周囲に辐射 スクリーンを配設してなる単結晶成長装置に関す ス

(従来の技術)

CZ法により単結晶を引上げる場合、単結晶は ルツボ、ヒータ、融液からの輻射熱を受け、単結 晶の引上方向における温度勾配が小さくなり、引 上効率が低下するので、この防止策として単結晶 の引上領域の周囲に輻射スクリーンを配設して輻 射熱を遮断している。

ところが、ルツボに原料を仕込む際、輻射スク リーンが邪魔になり、輻射スクリーンを配設しな い場合と比べて原料仕込量が少なくなる。このた め、製品重量当りのコストが大きく増加してしま う。

この問題点を解決する技術が特公昭58-10 80号公報に開示されている。

すなわち、単結晶成長装置の輻射スクリーンを 昇降及び旋回移動可能に構成し、原料仕込み時に 輻射スクリーンを上方へ移動させ、単結晶引上げ 時に輻射スクリーンを黒鉛リングの経部に定置さ せて用いるものである。

(発明が解決しようとする課題)

ところで近年、辐射スクリーンの下端と融液面 との距離が、 結晶の酸素濃度に大きく影響する ことが判明した。換言すれば、ルツボ内の液面高 さに応じて輻射スクリーンの配数位置を調整しな ければならない。しかるに、上記公報開示の装置 では、厳細な高さ調整を行い難いという不都合が ある。

本発明は上記不都合を解消することを課題としてなされた。

(課題を解決するための手段)

すなわち、本発明に係る単結晶成長装置は、 チャンバ内の単結晶引上げ領域の周囲に辐射スク リーンを配設してなる単結晶成長装置であって、 チャンバの上板に、上下方向へ螺進退可能に懸吊 材を取付け、鉄懸吊材によって、輻射スクリーン をチャンバ内に吊下保持させたものである。

ここで、上板に対する懸吊材の取付けは、直接 的であっても間接的であってもよく、また、懸吊 材に対する輻射スクリーンの吊下保持も、直接的 であっても間接的であってもよい。つまり仲介 材を配設するか否かを問わない。更に輻射スク リーンの吊下保持は、固定的な吊下保持以外に取 付け取り外し自在な吊下保持を含む。

(作用)

関ロされ、前記引上ロlaには保護筒5が立設されている。

保護簡5の上端からは引上軸5 a を用いて種結晶5 c を掴持するチャック5 b が吊下げられ、また、引上軸5 a の上端は図示しない回転、昇降機構に連繋されており、種結晶5 c を融液になじませた後、回転させつつ上昇させることによって、種結晶5 c 下端に単結晶7を成長せしめるようになっている。

本発明において、輻射スクリーン8は、チャンパ1の上板1bに、上下方向に移動可能に取付けられている。これを具体的に説明すると、9は上記輻射スクリーンを吊下保持する複数本の懸吊材であって、これら各懸吊材9,9・・・の各下端に一つの保持材10を共に固着し、以って各懸吊材であり、更に、上記保持材10の底面に複数のりてあり、更に、上記保持材10の底面に複数のリースの6級部8aに係合することにより、輻射スクリーン8を懸吊材9に取付け取外し可能に装着

上記の構成に依る単結晶成長装置は、上板に対する懸吊材の餌合量(度)に依って、駄懸吊材のチャンバー内に垂下する長さが変化し、この結果、上記懸吊材に吊下保持されている輻射スクリーンの高さ位置が変化する。

(実施例)

以下、本発明を添付図面に基づいて説明する。 第1図は本発明に係る単結晶成長装置の模式的 断面図であり、チャンバ1内にはその側周に保温 壁2が内張りされ、この保温壁2で囲われた中央 部にルツボ3が配設され、このルツボ3と保温壁 2との間にヒータ4がこれらとの間に排気用の通 気路を構成する間隔1 dを隔てて配設されている。

ルツボ3はグラファイト、石英等にて構成されており、底部中央にはチャンバ1の底壁を貫通させた軸3cの上端が連結され、該軸3cにて回転させつつ昇降せしめられるようになっている。

チャンパ1の上部壁中央にはチャンパ1内の雰囲気ガスの供給口を兼ねる単結晶の引上口1aが

している。上記鈎状片11は下方への突出量を変えられるように設けられて保持材10に取付けてあり、これにより輻射スクリーン8の下端と融液面とが平行になるように操作できる。

そして、上記懸吊材9のうち、一つのみが駆動 懸吊材9aとされ、他は上記保持材10を介して 同行移動せしめられる従動懸吊材9bとなされて いる。

まず、駆動懸吊材9aについて説明すると、鉄 駆動懸吊材9aの上端に雄ネジ軸12が突設して あり、鉄雄ネジ軸12を、チャンバ1の上板1b 上に設けた睢ネジ筒13に螺合せしめ、鉄睢ネジ 筒13を回転させることにより、駆動懸吊材9a が上下移動し、この結果、保持材10、従動懸吊 材9b及び輻射スクリーン8が一体として上下移 動する機成となしてある。

14は、懸吊材9の上下移動を許容すべく、 チャンパ1の上板1bに貢設された孔であり、該 孔14の周縁部に複数本の案内杆15が立設され、該案内杆15は、懸吊材9に張出し状に嵌合

特開平 3-279290(3)

固定されたスライドブレート16に嵌縁されている。また、上述の離ネジ筒13は、上記案内杆15によって回転可能に支持されており、更に上記懸吊材9の周囲には、外気を遮断するためのベローズ17が配設されている。

他方、従動態吊板9b側にも、孔14、案内杆 15、及びベローズ17が存し、スライドプレート16が設けられている。しかし、上記雄ネジ軸 12は設けられておらず、従って睢ネジ筒13も 存しない。

そして、従動懸吊板9b側では、従動懸吊板9 bの円滑な上下移動を担保すべく、スライドプレート16の下に、輻射スクリーン8の荷重に見合った(荷重を相致する)弾発力のスプリング1 8が配設されている。

上記機成の単結晶成長装置は、原料仕込み時に 雌ネジ筒13を回して輻射スクリーン8を上方へ 移動させて、原料を充分に仕込み、単結晶成長時 には、雌ネジ筒を逆転させて輻射スクリーン8を 下方に下げる。

る.

1…チャンバ

1 b …上板

7…単結晶

8…輻射スクリーン

9…懸吊材

特許出願人 大阪チタニウム製造株式会社

特許出願人 九州電子金属株式会社

代理人 弁理士 森 正 澄

なお、上記離ネジ筒 13の回転操作は、ハンドル6を人手で回す操作としてもよいが、制御手段を備えたモータ(図示せず)によって行わせてもよい。

そして、上述の辐射スクリーン8の上下移動操作は、雄ネジ軸12の螺進退に依るものであり、 輻射スクリーン8を所望とする高さ位置に確実に 設定できる。

(発明の効果)

以上説明したように、本発明に依れば、輻射スクリーンを上方に移動させて原料を多量に仕込むことができるばかりでなく、輻射スクリーンを確実に所望とする位置に設定できるため、輻射スクリーンの下端と融液面との距離調整が容易、且つ、正確に行うことができ、この結果、酸素濃度の均一な良質の単結晶が得られるという効果を有する。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示す単結晶成長装 量の断面図、第2図は同上の要部拡大断面図であ